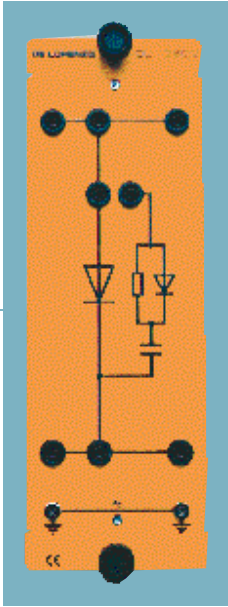


# ESPECIFICACIONES TECNICAS

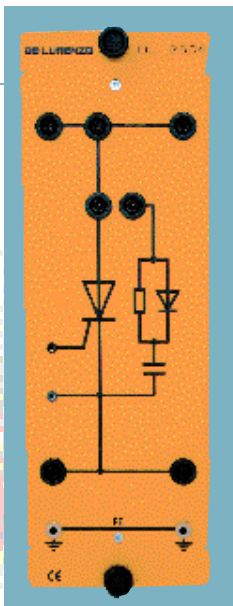


**DL 2602  
DIODO DE SILICIO**  
Diodo de silicio de recuperación rápida apropiado para realizar circuitos rectificadores; puede ser utilizado también como diodo de

libre circulación en los convertidores.

Características técnicas:

Corriente directa media  $I_{FAV} = 12 \text{ A max.}$   
 Corriente directa de sobrecarga no repetitiva  
 $I_{FSM} = 75 \text{ A (} t_p = 10 \text{ ms)}$   
 Voltaje inverso de pico repetitivo  
 $U_{RRM} = 1000 \text{ V}$   
 Tiempo de recuperación inverso  
 $t_p = 65 \text{ ns max.}$

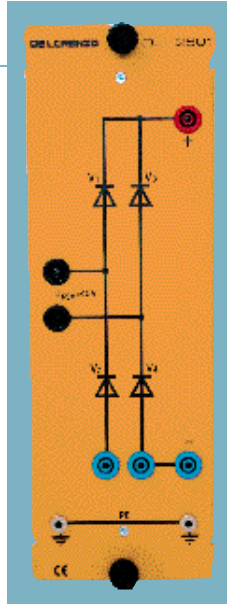


**DL 2604  
SCR**

Rectificador controlado de silicio utilizado en el control de la potencia, en los rectificadores controlados y en los inverter.

Características técnicas:

Corriente directa media  $I_{FAV} = 7,6 \text{ A max.}$   
 Valor eficaz de la corriente directa  $I_{TRMS} = 12 \text{ A}$   
 Máximo voltaje inverso repetitivo  $U_{RRM} = 800 \text{ V}$   
 Corriente de inicio  $I_{GT} = 15 \text{ mA max.}$   
 Voltaje de inicio  $U_{GT} = 1,5 \text{ V max.}$   
 $I^2t = 72 \text{ A}^2\text{s}$



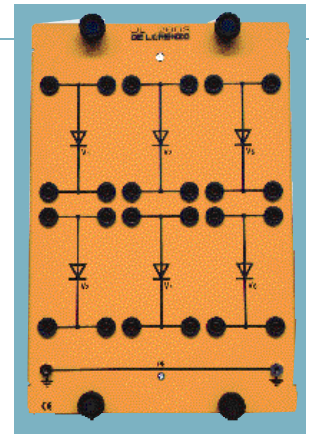
**DL 2601  
RECTIFICADOR DE SELENIO**  
Elementos de selenio utilizados en los rectificadores para convertir la corriente alternada en una corriente pulsante en sistemas de bajo voltaje.

Características técnicas:

Voltaje alternado nominal:  $30 \text{ Vrms}$   
 Voltaje continuo nominal:  $24 \text{ Vav}$   
 Corriente continua nominal:  $10 \text{ Aav}$

**DL 2603  
GRUPO DE DIODOS**

Seis diodos de silicio con recuperación rápida con red RCD de protección apropiada para realizar circuitos rectificadores no controlados.



Características técnicas:

Corriente directa media  $I_{FAV} = 12 \text{ A max.}$   
 Corriente directa de sobrecarga no repetitiva  $I_{FSM} = 75 \text{ A (} t_p = 10 \text{ ms)}$   
 Voltaje inverso de pico repetitivo  
 $U_{RRM} = 1000 \text{ V}$   
 Tiempo de recuperación inverso  
 $t_p = 65 \text{ ns max.}$